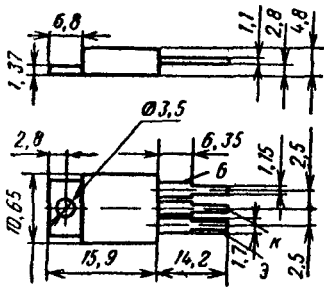


2Т819 (А, Б, В), 2Т819 (А2, Б2, В2), КТ819 (А, Б, В, Г), КТ819 (АМ, БМ, ВМ, ГМ)

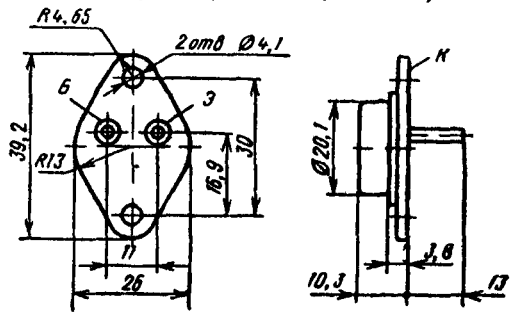
Транзисторы кремниевые меза-эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n* переключателные. Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах. Корпус металлический со стеклянными изоляторами и жесткими выводами (2Т819А—2Т819В, КТ819АМ—КТ819ГМ) и пластмассовый — с жесткими выводами (2Т819А2—2Т819В2, КТ819А—КТ819Г).

Масса транзистора не более 20 г для 2Т819А—2Т819В, КТ819АМ—КТ819ГМ и не более 2,5 г для 2Т819А2—2Т819В2, КТ819А—КТ819Г.

2Т819(А2-В2), КТ819(А-Г)



2Т819(А-В), КТ819(АМ-ГМ)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КВ}=5$ В, $I_K=5$ А, не менее:

$T = +25^\circ\text{C}$ и $T = T_{к макс}$:

2Т819А—2Т819В, 2Т819А2—2Т819В2, КТ819Б, КТ819БМ	20
КТ819А, КТ819В, КТ819АМ, КТ819ВМ	15
КТ819Г, КТ819ГМ	12

$T = T_{к мин}$:

2Т819А—2Т819В, 2Т819А2—2Т819В2, КТ819А—КТ819В, КТ819АМ—КТ819ВМ	10
КТ819Б, КТ819БМ	15
КТ819Г, КТ819ГМ	7

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КВ}=5$ В, $I_B=0,5$ А

3...5*...12* МГц

Граничное напряжение при $I_K=0,1$ А, $t_u \leq 300$ мкс, $Q \geq 100$:

КТ819А, КТ819АМ, не менее	25 В
КТ819Б, КТ819БМ, 2Т819В, 2Т819В2	40...60*...80* В
КТ819В, КТ819ВМ, 2Т819Б, 2Т819Б2	60...80*...100* В
КТ819Г, КТ819А, 2Т819А, 2Т819А2	80...100*...110* В

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер, не более:

при $I_K=5$ А, $I_B=0,5$ А:

2Т819А—2Т819В, 2Т819А2—2Т819В2	1 В
КТ819А—КТ819Г, КТ819АМ—КТ819ГМ	2 В

при $I_K=20$ А, $I_B=4$ А, 2Т819А—2Т819В, 2Т819А2—2Т819В2

1*...2,2*...5* В

при $I_K=15$ А, $I_B=3$ А КТ819А—КТ819Г, КТ819АМ—КТ819ГМ

4* В

Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_K=5$ А, $I_B=0,5$ А, не более:

2Т819А—2Т819В, 2Т819А2—2Т819В2	1,5 В
КТ819А—КТ819Г, КТ819АМ—КТ819ГМ	3 В

Пробивное напряжение коллектор — база при $T = -60...+25^\circ\text{C}$, $I_K=1$ мА и при $T = +125^\circ\text{C}$, $I_K=5$ мА, не менее:

2Т819А, 2Т819А2	100 В
2Т819Б, 2Т819Б2	80 В
2Т819В, 2Т819В2	60 В

Пробивное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{с.к} \leq 100$ Ом, $I_K=1$ мА, не менее:

2Т819А	100 В
2Т819Б	80 В
2Т819В	60 В

Пробивное напряжение эмиттер — база при $I_B=5$ мА, не менее

5 В

Обратный ток коллектора при $U_{КВ}=40$ В КТ819А—КТ819Г, КТ819АМ—КТ819ГМ не более:

$T = -40...+25^\circ\text{C}$	1 мА
$T = +100^\circ\text{C}$	10 мА

Время выключения при $I_K=5$ А, $I_B=0,5$ А, не более

2,5* мкс

Емкость коллекторного перехода при $U_{КВ}=5$ В

360* 600* 1000* пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{БЭ}=0,5$ В, $=1$ МГц, не более

2000* пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база

2Т819А, 2Т819А2	100 В
2Т819Б, 2Т819Б2	80 В
2Т819В, 2Т819В2	60 В

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{с.к} \leq 100$ Ом, $T = T_{к мин} + 50^\circ\text{C}$; $+40^\circ\text{C}$ для 2Т819А2—2Т819В2

КТ819А, КТ819АМ	40 В
КТ819Б, КТ819БМ	50 В
КТ819В, КТ819ВМ	70 В
2Т819А2, 2Т819А, КТ819Г, КТ819ГМ	100 В
2Т819Б2, 2Т819Б	80 В
2Т819В2, 2Т819В	60 В

Постоянное напряжение база — эмиттер

5 В

Постоянный ток коллектора:

КТ819А—КТ819Г	10 А
2Т819А—2Т819В, 2Т819А2—2Т819В2, КТ819АМ—КТ819ГМ	15 А

Импульсный ток коллектора при $t_u \leq 10$ мс, $Q \geq 100$ и $Q \geq 2$ для 2Т819А2—2Т819В2

КТ819А—КТ819Г	15 А
2Т819А2—2Т819В2, 2Т819А—2Т819В, КТ819АМ—КТ819ГМ	20 А

Постоянный ток базы

3 А

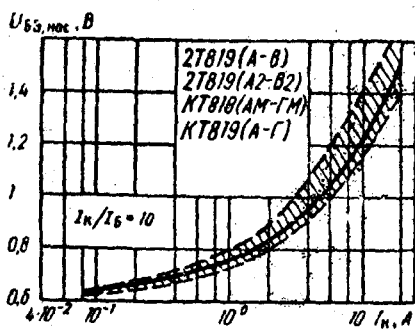
Импульсный ток базы при $t_u \leq 10$ мс, $Q \geq 100$

5 А

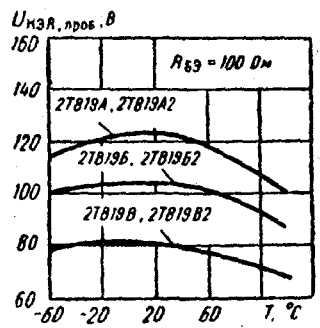
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора¹ при $T_K = T_{к мин} + 25^\circ\text{C}$

с теплоотводом	
2Т819А2—2Т819В2	40 Вт
КТ819А—КТ819Г	60 Вт
2Т819А—2Т819В, КТ819АМ, КТ819ГМ	100 Вт

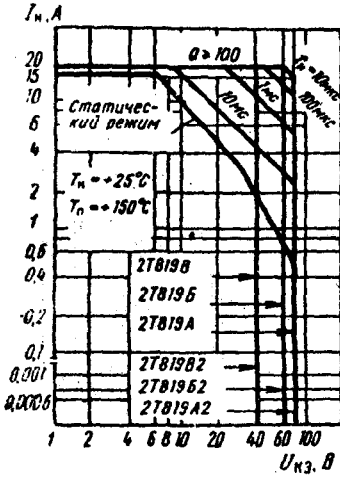
без теплоотвода	
2Т819А2—2Т819В2	1 Вт
КТ819А—КТ819Г	1,5 Вт
КТ819АМ—КТ819ГМ	2 Вт
2Т819А, 2Т819В	3 Вт



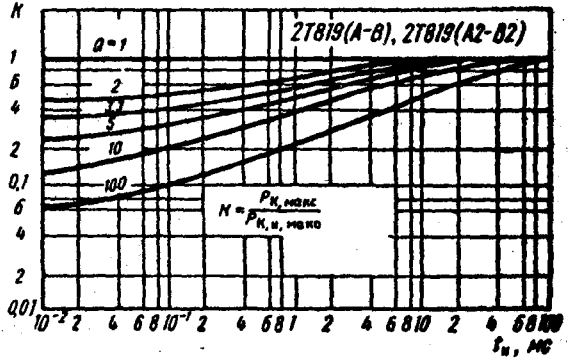
Зона возможных положений зависимости напряжения насыщения база — эмиттер от тока коллектора



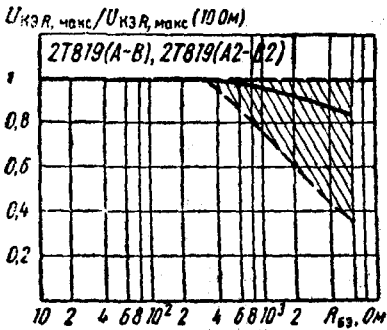
Зависимость пробивного напряжения коллектор — эмиттер от температуры



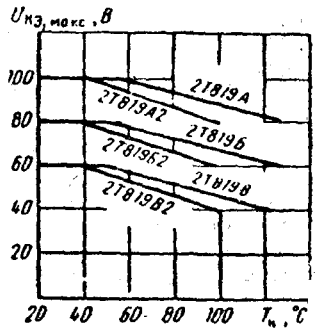
Область максимальных режимов



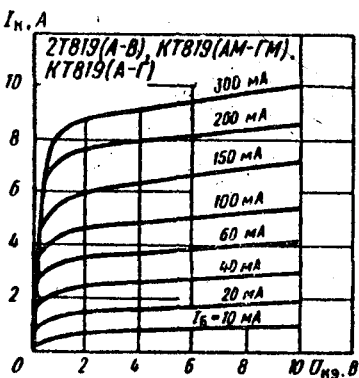
Зависимость коэффициента K от длительности импульса



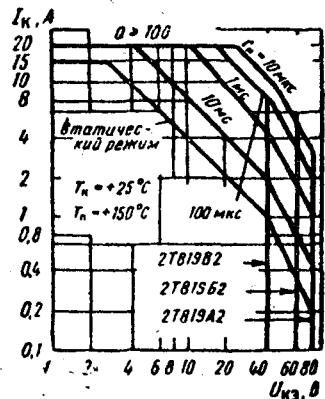
Зона возможных положений зависимости максимально допустимого напряжения коллектор — эмиттер от сопротивления база — эмиттер



Зависимость максимально допустимого напряжения коллектор — эмиттер от температуры корпуса



Выходные характеристики



Области максимальных режимов